

Product list/产品列表

硅片类型Silicon type	尺寸规格 size	正电极图形 Front electrode pattern
单晶Mono-crystalline	182*182±0.5Φ247mm	十主栅/ten busbar 间距interval/17.3mm

Appearance parameters/外观参数

参数项目 Parameter items		规格 Specification	公差 Tolerance	单位 Unit
正面 Front surface	A 细栅线数量 Finger quantity	160	-	Line
	B 正面焊盘宽度 Front busbar width	1.4	±0.1	mm
	C 主栅线间距 Distance between busbars	17.3	±0.15	mm
背面 Rare surface	a 背面主栅线的宽度 Back busbar width	1.4	±0.3	mm
	b 背面栅线之间的距离 Distance between back busbars	17.3	±0.15	mm
	c 背面细栅线数量 Back finger quantity	180	-	Line

Electrical performance/电性能

正面效率/Front Efficiency

档位 Eff (%)	效率区间 Efficiency	功率 Pmpp (W)	最大功率电流 Impp (A)	最大功率电压 Umpp (V)	短路电流 Isc (A)	开路电压 Uoc (V)
23.3	23.3以上	7.69	12.842	0.599	13.506	0.695
23.2	23.2-23.3	7.66	12.808	0.598	13.466	0.694
23.1	23.1-23.2	7.63	12.773	0.597	13.426	0.693
23.0	23.0-23.1	7.59	12.745	0.596	13.386	0.692
22.9	22.9-23.0	7.56	12.710	0.595	13.346	0.691
22.8	22.8-22.9	7.53	12.675	0.594	13.306	0.690
22.7	22.7-22.8	7.49	12.640	0.593	13.266	0.689
22.6	22.6-22.7	7.46	12.604	0.592	13.226	0.688